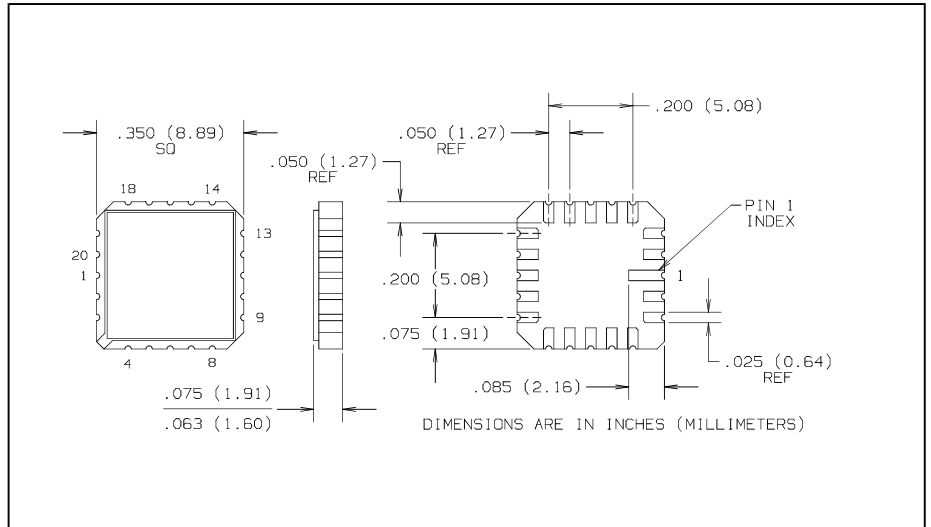


Surface Mount Quad PNP Transistor Type JANTX, JANTXV, 2N6987U



Features

- Ceramic surface mount package
- Hermetically sealed
- Small package minimizes circuit board area required
- Electrical performance similar to a 2N2907
- Qualification per MIL-PRF-19500/558

Description

The JANTX2N6987U is a hermetically sealed, ceramic surface-mount device, consisting of 4 silicon PNP transistors. The 20 pin ceramic package is ideal for designs where board space and device weight are important design considerations.

Typical screening and lot acceptance tests are provided on page 13-4. The burn-in condition is $V_{CB} = 30\text{ V}$, $P_D = 250\text{ mW}$ each transistor, $T_A = 25^\circ\text{ C}$. Refer to MIL-PRF-19500/558 for complete requirements.

When ordering parts without processing, do not use a JAN prefix.

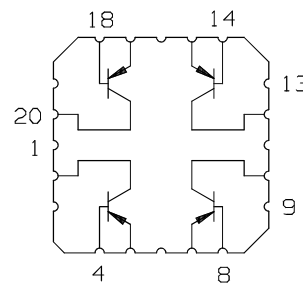
Absolute Maximum Ratings ($T_A = 25^\circ\text{ C}$ unless otherwise noted)

Collector-Emitter Voltage.....	60 V
Collector-Base Voltage.....	60 V
Emitter-Base Voltage.....	5 V
Collector Current Continuous.....	600 mA
Operating and Storage (T_J, T_{stg}).....	-65° C to $+200^\circ\text{ C}$
Power Dissipation (single transistor, no heat sink).....	0.5 W
Power Dissipation (total device).....	1 W ⁽¹⁾
Isolation Voltage.....	500 V

Notes:

(1) Derate linearly 8.57 mW/ $^\circ\text{ C}$ above $T_A = 25^\circ\text{ C}$.

Schematic



TOP VIEW

Type JANTX, JANTXV, 2N6987U

Electrical Characteristics ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	PARAMETER	MIN	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
Off Characteristics					
$V_{(BR)CBO}$	Collector-Base Breakdown Voltage	60		V	$I_C = 10\text{ mA}$
$V_{(BR)CEO}$	Collector-Emitter Breakdown Voltage	60		V	$I_C = 10\text{ mA}^{(2)}$
$V_{(BR)EBO}$	Emitter-Base Breakdown Voltage	5		V	$I_E = 10\text{ }\mu\text{A}$
I_{CBO1}	Collector-Base Cutoff Current		10	nA	$V_{CB} = 50\text{ V}$
I_{CBO2}	Collector-Base Cutoff Current		10	μA	$V_{CB} = 50\text{ V}, T_A = 150^\circ\text{C}$
I_{EBO}	Emitter-Base Cutoff Current		50	nA	$V_{EB} = 3.5\text{ V}$
On Characteristics					
h_{FE1}	Forward Current Transfer Ratio	75			$V_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 0.1\text{ mA}$
h_{FE2}	Forward Current Transfer Ratio	100	450		$V_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 1.0\text{ mA}$
h_{FE3}	Forward Current Transfer Ratio	100			$V_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 10\text{ mA}^{(2)}$
h_{FE4}	Forward Current Transfer Ratio	100	300		$V_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 150\text{ mA}^{(2)}$
h_{FE5}	Forward Current Transfer Ratio	50			$V_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 500\text{ mA}^{(2)}$
h_{FE6}	Forward Current Transfer Ratio	50			$V_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 1\text{ mA}, T_A = -55^\circ\text{C}^{(2)}$
$V_{CE(SAT)1}$	Collector-Emitter Saturation Voltage		0.4	V	$I_C = 150\text{ mA}, I_B = 15\text{ mA}^{(2)}$
$V_{CE(SAT)2}$	Collector-Emitter Saturation Voltage		1.6	V	$I_C = 500\text{ mA}, I_B = 50\text{ mA}^{(2)}$
$V_{BE(SAT)1}$	Base-Emitter Saturation Voltage		1.3	V	$I_C = 150\text{ mA}, I_B = 15\text{ mA}^{(2)}$
$V_{BE(SAT)2}$	Base-Emitter Saturation Voltage		2.6	V	$I_C = 500\text{ mA}, I_B = 50\text{ mA}^{(2)}$
Small-Signal Characteristics					
$ h_{fe} $	Magnitude of Small-Signal Short-Circuit Forward Current Transfer Ratio	2	8		$V_{CE} = 20\text{ V}, I_C = 50\text{ mA}, f = 100\text{ MHz}$
h_{fe}	Small-Signal Short Circuit Forward Current Transfer Ratio	100			$V_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 1\text{ mA}, f = 1\text{ kHz}$
C_{obo}	Open Circuit Output Capacitance		8	pF	$V_{CB} = 10\text{ V}, I_E = 0, 100\text{ kHz} \leq f \leq 1\text{ MHz}$
C_{ibo}	Input Capacitance		30	pF	$V_{EB} = 2\text{ V}, I_C = 0, 100\text{ kHz} \leq f \leq 1\text{ MHz}$
Switching Characteristics					
t_{on}	Turn-On Time		45	ns	$V_{CC} = 30\text{ V}, I_C = 150\text{ mA}, I_B = 15\text{ mA}$
t_{off}	Turn-Off Time		300	ns	$V_{CC} = 30\text{ V}, I_C = 150\text{ mA}, I_{B1} = I_{B2} = 15\text{ mA}$
Transistor to Transistor Isolation					
R_{t-t}	Isolation Resistance		10k	$M\Omega$	$V_{t-t} = 500\text{ V}$

(2) Pulsed Test: Pulse Width = $300\text{ }\mu\text{s} \pm 50$, 1-2 % Duty Cycle.

HI-REL
SURFACE
MOUNT



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331